

特点:

- 输出功率: +16 dBm
- 驱动输入信号范围: 0 ~ + 3 dBm
- 基波隔离度: > 55 dBc @ 40 GHz
- 工作电压电流: +5 V@180 mA
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 1.25×3.4×0.1 mm

性能参数: (T_A=+25℃, V_D=+5V)

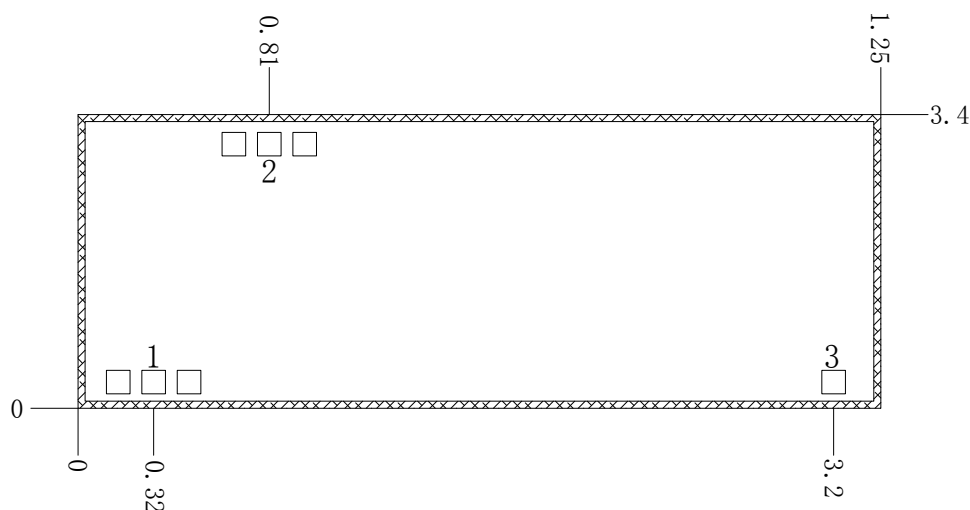
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
输入频率	f _{in}	Z _{in} =Z _{out} =50Ω P _{in} =0dBm	8		11	GHz	
输出频率	f _{out}		32		44	GHz	
输出功率	P		15	17		dBm	
基波抑制	SR1		20	60		dBc	
二次谐波抑制	SR2		30	55		dBc	
三次谐波抑制	SR3		40	55		dBc	
工作电流	ID	V _D =+5V		180		mA	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+5.5	V	贮存温度	-55~+150	℃

芯片尺寸图:

单位: mm

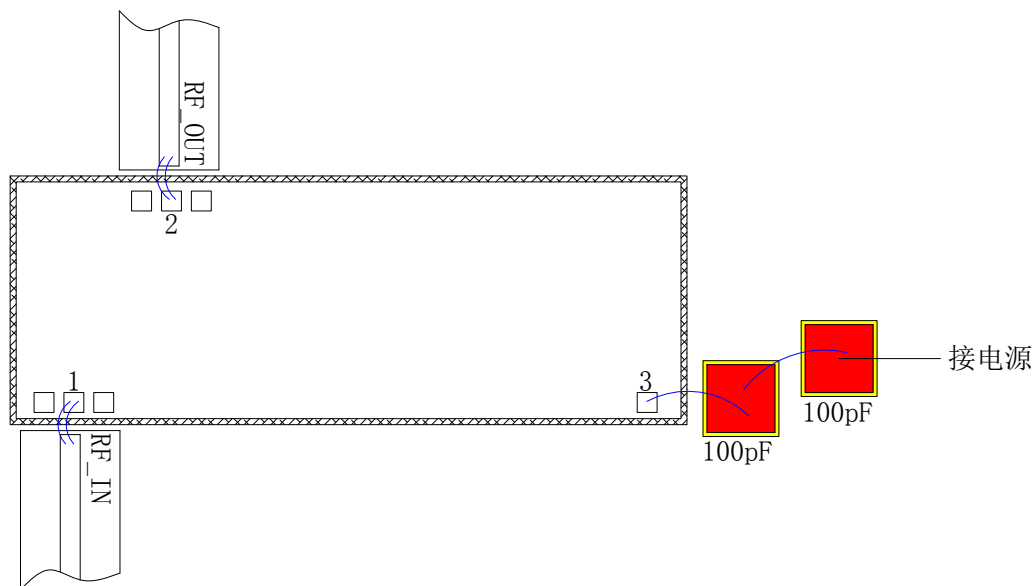


注: 典型键合焊盘尺寸为 100*100um

引脚定义：

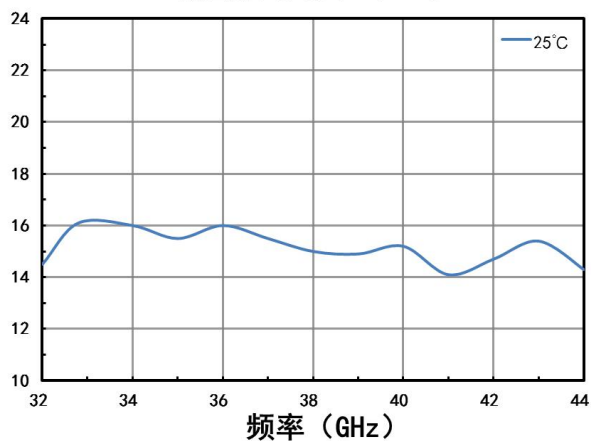
引脚	定义	描述
1	IN	射频输入端口
2	OUT	射频输出端口
3	VD	电源电压，需外接 2 个 100p 旁路电容
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

推荐装配图：

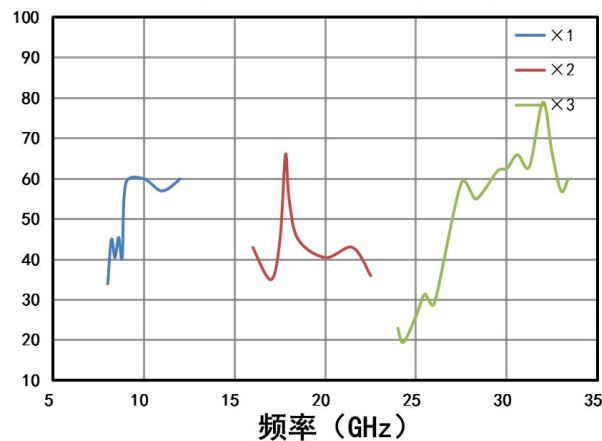


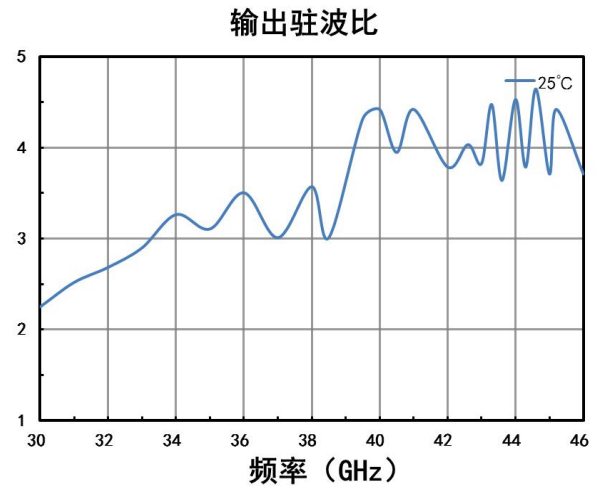
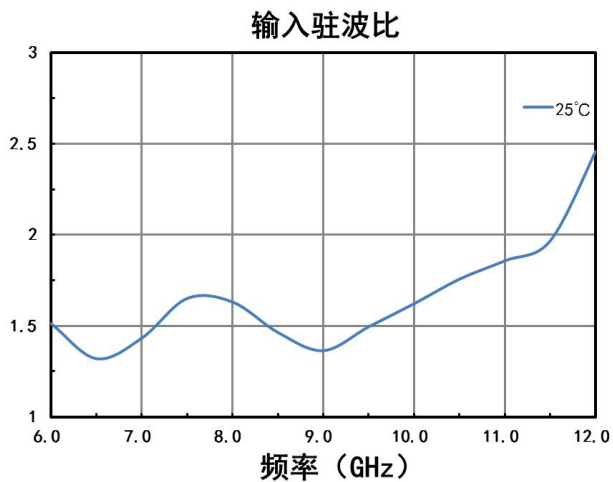
典型测试曲线：

输出信号功率 (dBm)



谐波抑制 (dBc) VS $\times 1$, $\times 2$, $\times 3$





产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。